

DHA<sup>®</sup>

QJ/DHA 09.34-2018

24N60

## N-沟道 MOSFET 功率晶体管

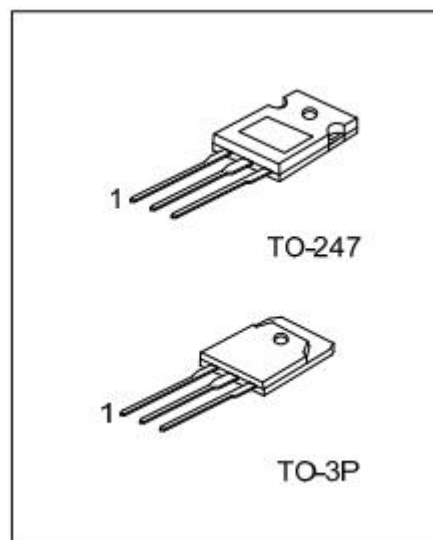
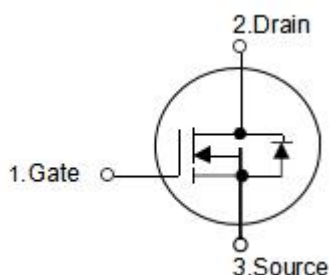
## 描述

24N60 是一款采用先进技术的N沟道增强型功率 MOSFET，为客户提供平面条纹和 DMOS 技术。该技术专门用于实现最小的导通电阻和卓越的开关性能。它还可以承受雪崩和换向模式下的高能脉冲。

## 用途

24N60 广泛应用于电机控制，UPS，DC 斩波器以及开关模式和谐振模式电源。

## 等效电路图

电参数 (T<sub>amb</sub> = 25°C)

缩写	参数	单位	最小值	典型值	最大值	测试条件
BV <sub>DSS</sub>	漏极-源极 击穿电压	V	600	-	-	V <sub>GS</sub> = 0 V, I <sub>D</sub> = 250 μA
I <sub>D</sub>	漏极连续电流	A	-	-	24.3	T <sub>J</sub> = 25 °C
R <sub>DS(on)</sub>	静态 漏极-源极 导通电阻	Ω	-	0.14	0.16	V <sub>GS</sub> = 10 V, I <sub>D</sub> = 15.4 A
V <sub>GS(th)</sub>	栅极门限电压	V	2.1	3	3.9	V <sub>DS</sub> = V <sub>GS</sub> , I <sub>D</sub> = 1.2 mA
I <sub>DSS</sub>	漏极-源极 漏电流	μA	-	0.1	1	V <sub>DS</sub> = 600 V, V <sub>GS</sub> = 0 V
I <sub>GSS</sub>	栅极-源极 漏电流	nA	-	-	100	V <sub>GS</sub> = ± 20 V, V <sub>DS</sub> = 0 V
T <sub>J</sub>	工作结温	°C	- 55 ~ +150			
T <sub>STG</sub>	储存温度范围	°C				